

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ
Mã hồ sơ:

Ảnh màu 4x6

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Giao thông vận tải; Chuyên ngành: Điều khiển trong Giao thông vận tải

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Đào Thanh Toán

2. Ngày tháng năm sinh: 28/11/1979; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: X. Vân Hà, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Phòng 501, Nhà N16, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Trường Đại học GTVT, Số 3, Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:; Điện thoại di động: 0979379099; E-mail:daotoan@utc.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

– Từ năm 2002 đến năm 2004: Trợ giảng, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học GTVT

– Từ năm 2004 đến năm 2009: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học GTVT

– Từ năm 2009 đến năm 2012: Nghiên cứu sinh, tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, 1-1 Asahidai, Thành phố Nomi, Tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

– Từ năm 2012 đến năm 2013: Nghiên cứu sau tiến sĩ, tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, 1-1 Asahidai, Thành phố Nomi, Tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

– Từ năm 2013 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học GTVT

– Từ năm 2017 đến nay: Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học GTVT

– Từ năm 2019: Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học GTVT

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ; Chức vụ cao nhất đã qua:

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học GTVT

Địa chỉ cơ quan: Số 3, Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02437663311

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 06 năm 2020, ngành: Vô tuyến điện và thông tin liên lạc, chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học GTVT, Việt Nam

– Được cấp bằng ThS ngày 03 tháng 01 năm 2008, ngành: Kỹ thuật Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học GTVT, Việt Nam

– Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 09 năm 2012, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Khoa học và Công nghệ nano (điện tử)

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm,

ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HDGS cơ sở: Trường Đại học GTVT

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HDGS ngành, liên ngành: GTVT

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

– Điều khiển điện áp ngưỡng trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ cho thiết bị điện tử, IoT thế hệ mới

– Nghiên cứu phát triển ứng dụng của điện tử hữu cơ trong giao thông thông minh

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

– Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

– Đã hoàn thành (số lượng) 02 đề tài NCKH cấp cơ sở; 01 đề tài NCKH cấp Bộ; 01 đề tài NCKH cấp NN (Nafosted);

– Đã công bố (số lượng) 36 bài báo KH, trong đó 18 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

– Đã được cấp (số lượng) bằng chế, giải pháp hữu ích;

– Số lượng sách đã xuất bản : 4, trong đó .. thuộc nhà xuất bản có uy tín;

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất

Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB, chỉ số ISBN; với công trình KH: ghi rõ tên công trình, tên các tác giả, tên tạp chí, tập, trang, năm công bố; nếu có thì ghi rõ tạp chí thuộc loại nào: ISI (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI), Scopus hoặc hệ thống CSDL quốc tế khác; chỉ số ảnh hưởng IF của tạp chí và chỉ số trích dẫn của bài báo.

– “Controllable threshold voltage of a pentacene field-effect transistor based on a double-dielectric structure”(Tiếng Việt: “Điều khiển điện áp ngưỡng của transistor hiệu ứng trường pentacene trên cơ sở cấu trúc điện môi kép”), *Toan Thanh Dao*, Toshinori Matsushima, Rainer Friedlein, and Hideyuki Murata, *Organic Electronics*, vol. 14, pp. 2007-2013, 2013, thuộc *SCI*, *IF*=3.676, số trích dẫn: 15

– “Controllable threshold voltage in organic complementary logic circuits with an electron-trapping polymer and photoactive gate dielectric layer” (Tiếng Việt: “Điều khiển điện áp ngưỡng của mạch logic bù hữu cơ với polyme bẫy điện tử và lớp điện môi công tích

cực”), **Toan Thanh Dao**, Heisuke Sakai, Hai Thanh Nguyen, Kei Ohkubo, Shunichi Fukuzumi, and Hideyuki Murata, ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 8, pp.18249-18255, 2016, *thuộc SCI, IF=7.504, số trích dẫn: 2*

– “Sử dụng polyme chế tạo cảm biến áp lực mềm ứng dụng trong đo đạc, quan trắc công trình”, **Đào Thanh Toản**, Tạp chí Khoa học GTVT số 62, tr.50-56, 2018.

– “Development of an organic pressure active sensor for sensing vehicle via smart-phone and internet of things” (Tiếng Việt: “Phát triển cảm biến áp lực tích cực hữu cơ ứng dụng để xác định phương tiện giao thông qua điện thoại thông minh và IoT”), **Thanh Dao Toan**, In Proceedings of the 2018 International Conference of Sustainability on Civil Engineering (ICSCE 2018), Tạp chí GTVT, ISSN:2354-0818, pp. 222-224, 2018

– Giáo trình: “Kỹ thuật Điện tử”, **Đào Thanh Toản**, Nguyễn Thúy Bình, Hồ Thành Trung, NXB Giao thông Vận tải, 2017, ISBN: 978-604-76-1433-2.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

– Chứng nhận giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải "sinh viên nghiên cứu khoa học", của bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008;

– Giải thưởng báo cáo xuất sắc và huy chương của hiệp hội vật lý ứng dụng Nhật Bản chi nhánh Hokuriku Shin-etsu, tại hội nghị khoa học năm 2011;

– Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường ĐH GTVT đã có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2018;

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): KHÔNG

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá).

Dựa theo các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định trong Luật giáo dục và luật Khoa học và Công nghệ, ứng viên tự đánh giá:

– Được đào tạo theo hệ chính qui hệ đại học và cao học (Trong nước), tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ (Nước ngoài), công tác và làm việc trong môi trường giáo dục, nghiên cứu (Trường ĐH GTVT, Viện JAIST-Nhật Bản) từ 2002. Có đủ khả năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) để thực hiện các công việc liên quan đến giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn.

– Nhiệm vụ giảng dạy: tham gia giảng dạy các môn học ở bậc đại học, hướng dẫn sinh viên và học viên cao học: thực hiện đồ án tốt nghiệp và luận văn Thạc sĩ. Tổng số tiết giảng hàng năm đều vượt chuẩn.

– Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Đã và đang là chủ nhiệm và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học tại các hội nghị khoa học, trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Số giờ nghiên cứu khoa học hàng năm đều vượt chuẩn.

– Các hoạt động chuyên môn khác:

• *Đóng góp trong cộng đồng khoa học*: là thành viên ban tổ chức hội nghị và hợp tác quốc tế của hội vô tuyến điện tử Việt Nam (REV), thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Giao thông Đông Á (EASTS). Tham gia tổ chức và phản biện bài báo cho hội nghị khoa học quốc tế như IEEE ATC, IEEE SigTelCom,... Phản biện bài báo cho tạp chí khoa học trong nước và quốc tế như: Tạp chí Khoa học GTVT; The Journal of Electronic Materials (Springer); Organic Electronics (Elsevier),... Tham gia các hội đồng xét duyệt và nhiệm vụ đề tài nghiên cứu của Đại học GTVT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải.

• *Xây dựng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và trường Đại học*: Là cầu nối trong việc thiết lập và triển khai các hoạt động quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp như Tập đoàn Renesas, FPT unit 11, Viện JAIST, Đại học Điện tử-Truyền thông Tokyo, Nhật Bản,...

– Thường xuyên học tập và rèn luyện nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục và nghiên cứu khoa học được Nhà Trường giao phó.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 11 năm.

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ)

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2013-2014	0	0	0	75	285	139	349/424
2	2014-2015	0	0	50	45	355	168	428/523
3	2015-2016	0	0	50	30	305	0	225/311
3 năm học cuối								
4	2016-2017	0	0	25	18	385	90	432/475
5	2017-2018	0	0	0	18	338	164	484/502
6	2018-2019	0	0	0	180	480	62	362/542

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

– Bảo vệ luận án TS ; Tại nước: Nhật Bản năm 2012

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEFL ITP 503 điểm, ngày 17/04/2009

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từ đến ...	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Vũ Ngọc Quý		X	X		05/2014 – 05/2015	Trường Đại học GTVT	2015
2	Lê Anh Xuân		X	X		11/2014 – 06/2015	Trường Đại học GTVT	2015
3	Dương Duy Hà		X	X		05/2015 – 12/2015	Trường Đại học GTVT	2015
4	Vũ Tuấn Anh		X	X		11/2014 – 01/2016	Trường Đại học GTVT	2016
5	Nguyễn Ngọc Diệp		X	X		05/2015–12/2016	Trường Đại học GTVT	2017

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Viết MM hoặc CB, phần biên soạn	Xác nhận của CS GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị TS						
1	Kỹ thuật Điện tử số	GT	Nhà xuất bản GTVT, 2016	02	• Chủ biên; • Phần biên soạn: 3-27; 66-184	X
2	Kỹ thuật Đo lường Điện tử	GT	Nhà xuất bản GTVT, 2017	02	• Chủ biên; • Phần biên soạn: 1-108; 239-272	X
3	Kỹ thuật Điện tử	GT	Nhà xuất bản GTVT, 2017	03	• Chủ biên; • Phần biên soạn: 9-70; 141-188	X
4	Kỹ Thuật điện tử tương tự	GT	Nhà xuất bản GTVT, 2019	04	• Chủ biên	X

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS): 0

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	ĐT: Truyền số liệu dùng vi xử lý	CN	T2004-ĐDT-39 Cấp Cơ sở Trường ĐH GTVT	01/2004-12/2004	01/02/2005
2	ĐT: Nghiên cứu hệ thống thông tin vô tuyến trong đường hầm	CN	T2006-ĐDT-61 Cấp Cơ sở Trường ĐH GTVT	01/2006-12/2006	06/07/2007
3	ĐT: Nghiên cứu mạch tích hợp CMOS hữu cơ có thể điều khiển điện áp ngưỡng bằng phương pháp điện trên đế silic và đế dẻo sử dụng polymer bẫy điện tử	CN	103.99-2013.13 Cấp NN (Nafosted)	2014-2016	09/08/2016
4	ĐT: Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID	CN	B2015-04-16 Cấp Bộ (Giáo dục và Đào tạo)	2014-2016	26/01/2018

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/số	Trang	Năm công bố
A-Trước khi bảo vệ học vị TS								

1	High-performance nonvolatile write-once-read-many-times memory devices with ZnO nanoparticles embedded in polymethylmethacrylate	7 <i>(tác giả chính)</i>	Applied Physics Letters ISSN: 0003-6951 NXB: American Institute of Physics, Hoa kỳ	SCI (IF ₂₀₁₁ =3.844 IF ₂₀₁₈ =3.495)	21	99/23	233303/1-3 và 4 trang phụ lục	2011
2	Observation of conductive filament formation in an organic non-volatile memory resistor device	7 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2012 IEEE International Meeting for Future of Electron Devices, Kansai ISBN: 978-1-4673-0837-3 DOI:10.1109/IMFEDK.2012.6218570	Scopus	1		38-39	2012
3	Organic nonvolatile memory transistors based on fullerene and an electron-trapping polymer	3 <i>(tác giả chính)</i>	Organic Electronics ISSN: 1566-1199 NXB: Elsevier, Hà Lan	SCI (IF ₂₀₁₂ =3.836 IF ₂₀₁₈ =3.680)	27	13/11	2709-2715	2012
B-Sau khi bảo vệ học vị TS								
4	Controllable threshold voltage of a pentacene field-effect transistor based on a double-dielectric structure	4 <i>(tác giả chính)</i>	Organic Electronics ISSN: 1566-1199 NXB: Elsevier, Hà Lan	SCI (IF ₂₀₁₃ =3.676 IF ₂₀₁₈ =3.680)	15	14/8	2007-2013	2013
5	Fabrication and characterization of flexible organic CMOS integrated circuits with PMMA dielectric	2 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2013 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification ISBN:978-4-88552-282-6		0		36-41	2013
6	Uniaxial macroscopic alignment of conjugated polymer systems by directional crystallization during blade coating	6 <i>(đồng tác giả)</i>	Journal of Materials Chemistry C ISSN: 2050-7526 NXB: Royal Society of Chemistry, Anh	SCI (IF ₂₀₁₄ =4.696 IF ₂₀₁₈ =5.976)	19	2/17	3303-3310	2014
7	Enhancement of ultraviolet light responsivity of a pentacene phototransistor by introducing photoactive molecules into a gate dielectric	6 <i>(tác giả chính)</i>	Japanese Journal of Applied Physics ISSN: 0021-4922 NXB: IOP Publishing, Anh	SCI (IF ₂₀₁₄ =1.127 IF ₂₀₁₈ =1.452)	7	53/2S	02BB03/1-5	2014
8	Bendable organic memristors in a crossbar array: applications to information storage	1 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications ISBN: 978-1-4799-	Scopus	0		32 - 35	2014

			6955-5 DOI:10.1109/ATC.2014.7043351						
9	Reduction of operating voltage in organic transistor and CMOS circuit utilizing high-K dielectric	2 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications ISBN: 978-1-4799-6955-5 DOI:10.1109/ATC.2014.7043416	Scopus	1		383-386	2014	
10	Impact of gate dielectric thickness in organic CMOS transistor performance for CAD design	4 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology ISBN:978-604-911-946-0		0		217-223	2014	
11	Operational analysis of nanoscale ReRAM cell with Matlab	2 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2014 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification ISBN:978-4-88552-294-9		0		152-154	2014	
12	Computer-aided design and verification of organic CMOS integrated circuits for bioelectronics	4 <i>(đồng tác giả)</i>	In Proceedings of the 2014 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification ISBN:978-4-88552-294-9		0		14-19	2014	
13	Tunable threshold voltage of organic CMOS inverter circuits by electron trapping in bilayer gate dielectrics	2 <i>(tác giả chính)</i>	IEICE Transactions on Electronics ISSN: 1745-1353 NXB: IEICE, Nhật Bản	SCIE <small>(IF₂₀₁₅= 0.344 IF₂₀₁₈= 0.516)</small>	7	98/5	422-428	2015	
14	Stretched-exponential distribution for investigation of stability of tuned threshold voltage organic CMOS	2 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2015 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification ISBN:978-4-88552-300-7		0		166-171	2015	
15	Bộ so sánh hữu cơ công nghệ bù, công suất thấp	4 <i>(đồng tác giả)</i>	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng ISSN :1859-1531		0	96/11	94-98	2015	
16	Programmable organic CMOS with SiO ₂ and polymer gate dielectrics	2 <i>(tác giả chính)</i>	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 ISBN:978-604-938-722-7		0		814-817	2015	

17	Synthesis of gold nanoparticles capped with quaterthiophene for transistor and resistor memory devices	5 (<i>đồng tác giả</i>)	Journal of Chemistry ISSN: 2090-9063 NXB: Hindawi, Anh	SCIE (IF ₂₀₁₆ = 1.300 IF ₂₀₁₈ = 1.726)	2	2016	8 trang	2016
18	Achieving high on/off ratio and good stability in organic nonvolatile resistive memory devices with polyisocyanide bearing oligothiophene	7 (<i>đồng tác giả</i>)	Japanese Journal of Applied Physics ISSN: 0021-4922 NXB: IOP Publishing, Anh	SCI (IF ₂₀₁₆ = 1.384 IF ₂₀₁₈ =1.452)	3	55/3S2	03DC10/1-4	2016
19	Design and simulation of a 6 bit successive-approximation ADC using modeled organic thin-film transistors	5 (<i>tác giả chính</i>)	Active and Passive Electronic Components ISSN: 0882-7516 NXB: Hindawi, Anh	ESCI	2	2016	11 trang	2016
20	Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo PET	4 (<i>đồng tác giả</i>)	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM ISSN: 1859-0128		0	19/T2	12-18	2016
21	Organic complementary amplifier circuits with mixed dielectrics for large-area active collision detection sensors	1 (<i>tác giả chính</i>)	In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Integrated Circuit Design and Technology ISBN: 978-1-5090-0827-8 DOI: 10.1109/ICICDT.2016.7542065	Scopus	0		4 trang	2016
22	Controllable threshold voltage in organic complementary logic circuits with an electron-trapping polymer and photoactive gate dielectric layer	6 (<i>tác giả chính</i>)	ACS Applied Materials & Interfaces ISSN: 1944-8244 NXB: American Chemical Society, Hoa Kỳ	SCI (IF ₂₀₁₆ = 7.504 IF ₂₀₁₈ =8.097)	2	8/28	18249–18255	2016
23	Fabrication of electrode by inkjet printer for flexible large-area electronics	2 (<i>tác giả chính</i>)	In Proceedings of the 3 rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology ISBN: 978-604-95-0010-7		0		224-227	2016
24	Fabrication and SPICE modeling of a low-voltage organic thin-film transistor with PVC gate dielectric	4 (<i>đồng tác giả</i>)	In Proceedings of the 3 rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology ISBN: 978-604-95-0010-7		0		308-311	2016

25	Performance evaluation of SAR ADC with organic semiconductor	3 <i>(đồng tác giả)</i>	In Proceedings of the International Conference on Advances in Information and Communication Technology ISBN: 978-3-319-49073-1	Scopus	0		452-459	2016
26	Photoelectrical characteristics of UV organic thin-film transistor detectors	1 <i>(tác giả chính)</i>	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics ISSN: 0866-8612 DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4077		0	33/2	74-81	2017
27	A low-power complementary organic double-edge triggered D flip-flop with variable-threshold voltage transistors	3 <i>(đồng tác giả)</i>	In Proceedings of the 2017 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification ISBN: 978-1-5386-3377-9	Scopus	0		121-126	2017
28	Xây dựng và hiệu chỉnh mạch đọc cảm biến áp lực hữu cơ	6 <i>(đồng tác giả)</i>	Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin ISBN: 978-604-67-1021-9		0		206-210	2017
29	Sử dụng polyme chế tạo cảm biến áp lực mềm ứng dụng trong đo đạc, quan trắc công trình	1 <i>(tác giả chính)</i>	Tạp chí Khoa học GTVT ISSN:1859-2724		0	62	50-55	2018
30	Demonstration of a bending detection system for railway sleepers based on a printed large-area pressure sensor	1 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the Vietnam railway development and experiences of China railway development and experiences of China ISBN:978-604-76-1572-8		0		167-172	2018
31	Wireless monitoring of vehicle on road using a flexible organic pressure passive sensor and a tablet	1 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of The 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam – Vision and Solutions ISBN: 978-604-76-1628-2		0		19-23	2018
32	Development of an organic pressure active sensor for sensing vehicle via smart-phone and internet of things	1 <i>(tác giả chính)</i>	In Proceedings of the 2018 International Conference of Sustainability on Civil Engineering ISSN:2354-0818		0		222-224	2018

33	Thiết kế mạch giao tiếp với cảm biến áp lực hữu cơ, ứng dụng theo dõi bước chân trên điện thoại thông minh, máy tính bảng	6 (<i>đồng tác giả</i>)	Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin lần thứ 21 ISBN: 978-604-80-3579-2		0		203-206	2018
34	Control of threshold voltage and low-voltage operation in organic field effect transistor	4 (<i>đồng tác giả</i>)	IEICE Transactions on Electronics ISSN: 1745-1353 NXB: IEICE, Nhật Bản	SCIE (IF ₂₀₁₈ =0.516)	0	E102-C/2	184-187	2019
35	Wearable device for monitoring heart rate based on low-cost piezoresistive sensor	8 (<i>đồng tác giả</i>)	In Proceedings of the 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies ISBN: 978-1-7281-1184-1 DOI: 10.1109/MOCAS.2019.8741734		0		4 pages	2019
36	An organic RRAM chip fabricated using ink-jet printer and its readout circuit for data storage	1 (<i>tác giả chính</i>)	In Proceedings of the 2019 IEEE The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing ISBN: 978-1-5386-7963-0 DOI: 10.1109/SIGTELCO M.2019.8696215	Scopus	0		140-144	2019

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS: **9**

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Số tác giả
----	--	-----------------	--------------------	------------

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được cấp bằng TS: 0

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...)

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
----	-----------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được cấp bằng TS: 0

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học

Tham gia phát triển chương trình đào tạo bậc đại học: Kỹ thuật Điện tử và Tin học công nghiệp, Tự động hóa, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa giao thông; thạc sĩ: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện tử.

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:
- Giờ chuẩn giảng dạy:
- Công trình khoa học đã công bố:
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Hướng dẫn NCS,ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
Người đăng ký

Đào Thanh Toàn

D. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NƠI ĐANG LÀM VIỆC

1. Những nội dung “Thông tin cá nhân” TS. Đào Thanh Toàn đã kê khai là đúng với Hồ sơ Trường Đại học Giao thông vận tải quản lý;
2. TS. Đào Thanh Toàn là giảng viên trong biên chế của Trường Đại học Giao thông vận tải, đã tham gia giảng dạy đại học từ năm 2004 đến nay và giảng dạy sau đại học từ năm 2013 đến nay.

Trong thời gian công tác nói trên, TS. Đào Thanh Toàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên.

Những nội dung còn lại, TS. Đào Thanh Toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long